

2025年1月29日(木)

開始時刻	終了時刻	内容	タイトル	所属	講演者
9:00	9:10	Opening	開会のあいさつ		
チュートリアル					
9:10	10:40	チュートリアル	MOSTランジスタ研究43年 ～ 半導体デバイスの進化と共に	帝京大学	高木 信一
10:40	11:00	Break			
S1-1					
11:00	11:50	基調講演	3D不揮発メモリの最新研究動向	キオクシア	齋藤真澄
11:50	12:05	写真撮影			
12:05	13:05	Lunch			
S1-2					
13:05	13:35	招待講演	14族元素からなる二次元物質：14族ナノシート	名古屋大学	黒澤昌志
13:35	13:55	一般講演	グラフェンと遷移金属ダイカルコゲナイドの直交的ヘテロ積層による単原子長ゲート・トランジスタの作製と特性評価	東北大学	HE QIYUE
13:55	14:15	一般講演	WSe <sub>2</sub> 上へのF6-TCNNQ成膜を用いたCFET構造デバイスへの応用	千葉大学	松田 健生
14:15	14:35	一般講演	選択的H <sub>2</sub> 導入を用いた分子線エピタキシーにより作製した GeSn/GeSiSn 共鳴トンネルダイオードの室温動作	名古屋大学	鳥本 昇汰
14:35	14:45	Break			
P ポスターセッション					
14:45	16:25	ポスター			
16:25	16:35	Break			
S1-3					
16:35	17:05	招待講演	遷移金属窒化物/Ge 界面でのショットキー障壁変調とその応用	熊本大学	山本圭介
17:05	17:25	一般講演	導電性酸化膜/p型Geにおける高いショットキー障壁	産総研	前田 辰郎
17:25	17:45	一般講演	強誘電Hf <sub>x</sub> Zr <sub>1-x</sub> O <sub>2</sub> 薄膜における最表面ZrO <sub>2</sub> 層駆動の結晶化促進メカニズムの理解	東京大学	高久 理名
懇親会					
18:00	20:00	懇親会			

2025年1月30日(金)

開始時間	終了時間	内容	タイトル	所属	講演者
8:55	9:00		2日目案内		
S2-1					

9:00	9:50	基調講演	GAAFETにおけるエピおよび基板技術	明治大学	小椋 厚志
9:50	10:10	Break			
6 企画セッション(予定)					
10:10	12:10	企画セッション	EUV リソグラフィ技術の歴史と将来		
				九州大学	溝口 計
				KEK	本田 洋介
				大阪大学	古澤 孝弘
				Rapidus	川邊 裕己
12:10	13:10	Lunch			
S2-2					
13:10	13:40	招待講演	内包空間に分布する浮遊電子状態が支配するSiNフラッシュメモリー機能	東北大学	押山 淳
13:40	14:00	一般講演	シリコン窒化膜/シリコン酸化膜積層構造の電荷捕獲機構に寄与する水素と塩素の役割	東京都市大学	矢藤 秀幸
14:00	14:20	一般講演	4H-SiCに対する窒化過程の N導入反応速度の窒化時間依存性を考慮した速度論の再考	東京大学	吉田 遥希
14:20	14:40	一般講演	4H-SiC(0001)の直接NO酸窒化時間によるMOS界面特性変化の原因の考察	東京大学	内田 雄太郎
14:40	15:00	一般講演	Record-Low Carrier Densities in Polycrystalline p- and n-Type Ge Thin Films via Hydrogen Passivation	筑波大学	野沢 公暉
15:00	15:20	Break			
S2-3					
15:20	15:50	招待講演	二次元チャネル材料 創製、デバイス、コンタクト(仮)	産総研	川那子 高暢
15:50	16:20	招待講演	カルコゲナイド材料薄膜の創生とデバイス応用(仮)	東北大学	齊藤 雄太
16:20	16:40	一般講演	Si/SiO <sub>2</sub> 界面における帯電欠陥が誘起するバンド端状態	産総研	中山 隆史
16:40	16:50	Break			
表彰式・閉会式					
16:50	17:10	Closing	表彰式など		

ポスターセッション	ID	タイトル	所属	講演者
1月29日 14:50-16:30	P01	ALD-HZO薄膜の低温結晶化におけるH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 酸化剤のH <sub>2</sub> O酸化剤に対する本質的優位性	東京大学	車 浩銘
	P02	電圧印加硬X線光電子分光法を用いたSiN膜中の電荷トラップ位置の推定	東京都市大学	桐原 芳治
	P03	SiOCH低誘電材料のデータ駆動型探索	KOKUSAI ELECTRIC	蓮見 玲乃

コアタイム  
IDが奇数の講演者  
前半(14:50-15:40)  
IDが偶数の講演者  
後半(15:40-16:30)

P04	SrTiO <sub>3</sub> (111)基板上に成長したNbドーブ (Ga <sub>0.75</sub> In <sub>0.25</sub> ) <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 固溶体薄膜の多形相転移 と電子物性に関する研究	明治大学	渡邊 允晴
P05	古典分子動力学法による HfO <sub>2</sub> 結晶の 強誘電体特性のシミュレーション	早稲田大学	大場 淳平
P06	エピタキシャルCaGe <sub>2</sub> 成長による金属/n- Ge(111)界面におけるSBH低減	名古屋大学	雪竹 遼馬
P07	分子動力学法によるSiGe混晶の低エネ ルギー局在フォノンモードの解析	早稲田大学	宮城 太一
P08	ODLTSによる高濃度炭素ドーブGaN層中 の欠陥評価	愛知工業大学	稲吉 桃子
P09	TMAHエッチング処理およびO <sub>3</sub> 表面酸化処理 がβ-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 基板表面構造とMOS界面特性に 与える効果の違い	東京大学	今飯田 捷真
P10	極薄膜Si-capを用いたGe MOSキャパシ タの作製と特性評価	千葉大学	高橋 大輝
P11	二次元半導体チャネルMOSFETの電気 的特性評価	筑波大学	佐藤 優
P12	p-Ge <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> n-Geダイオードのメサ深さ制 御による逆方向電流抑制	名古屋大学	山本 慶
P13	コンダクタンス法によるCVD単層MoS <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> MOSFETの界面準位密度評価におけるチャ ネル長の影響に関する研究	千葉大学	中村 志穂
P14	4H-SiC/SiO <sub>2</sub> 界面におけるバンド配列の 理論解析:NOアニール処理の影響	三重大学	伊勢 直斗
P15	トンネルFET用Ti <sub>0.3</sub> Zn <sub>0.7</sub> /O <sub>1.3</sub> /Si接合の界面構 造がトンネル電流特性に与える影響	明治大学	小川 健太
P16	TiN/ZrO <sub>2</sub> /TiNキャパシタの分極緩和	筑波大学	栗原 辰昇
P17	ナノシート酸化物半導体のMOS界面評価	産総研	上沼 睦典
P18	深層学習デノイズと短時間計測AR-XPS逆解 析による多層薄膜界面の高精度可視化	パキウムプロダク	豊田 智史
P19	放射光計測データの解析システムの性 能向上と機能拡張	愛知工業大学	大崎 陽介
P20	界面エネルギー計算によるα-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0001)基 板上のGa <sub>2</sub> O <sub>3</sub> の構造安定性の理論解析	三重大学	石田 宏樹
P21	ビニルシラン熱CVD法によるFe基板上のSiC 薄膜形成におけるアンモニア前処理の役割	愛知工業大学	大島 直人
P22	Si(111)表面におけるLinear-Parabolic Growth遅延の酸素分圧依存性	日本大学	Hengyu Wen
P23	SiO <sub>2</sub> /Si界面空孔のO <sub>2</sub> 反応メカニズム:p 型/n型と酸化温度比較から	日本大学	岡部 優希

P24	ALDによるWSe <sub>2</sub> へのHigh- $\kappa$ 絶縁膜直接成長:UV-O <sub>3</sub> 処理による界面制御	千葉大学	榎本 璃玖
P25	薄膜WSe <sub>2</sub> を用いたMISキャパシタおよびFETにおける界面特性のオゾン処理効果	千葉大学	岩崎 天星
P26	酸化インジウム薄膜粒内の結晶方位揺らぎの評価	産総研	工藤 晃哉
P27	電子線照射誘起欠陥と熱処理挙動に基づく4H-SiCの半絶縁化および光応答特性評価	愛知工業大学	神谷 龍希
P28	CF <sub>4</sub> /H <sub>2</sub> プラズマ照射がSiおよびSi <sub>0.7</sub> Ge <sub>0.3</sub> 表面に及ぼす影響	名古屋大学	佐分利 伊吹
P29	SiC-MOS界面に導入されたN原子が電子状態・キャリア散乱特性に与える効果の理論計算	神戸大学	小野 倫也